



## 新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置：首页 > 新闻动态 > 图片新闻

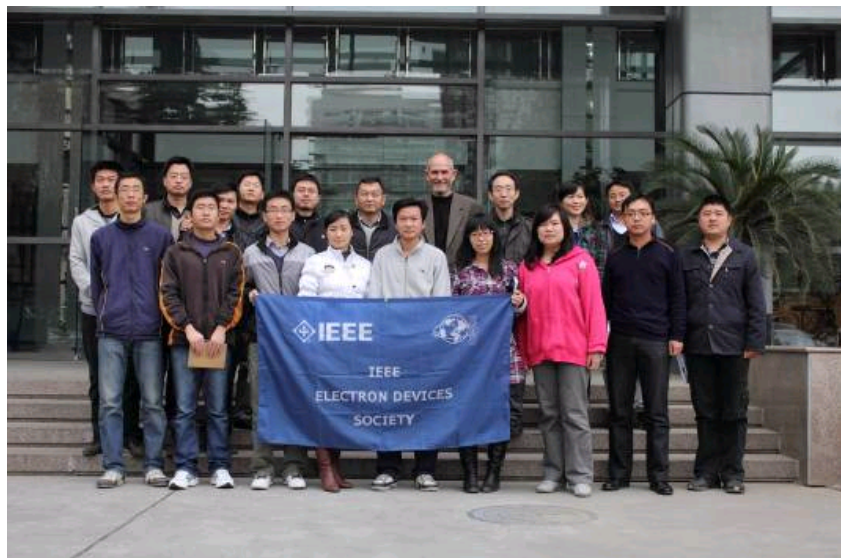
## 西班牙巴塞罗那自治大学 Jordi Suné教授来微电子所进行学术交流

2011-11-15 | 编辑：三室 孙海涛 王艳花 | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

应微电子所纳米加工与新器件集成技术研究室主任刘明研究员的邀请，11月2日，西班牙巴塞罗那自治大学的Jordi Suné教授来微电子所做学术交流，并作了题为Threshold switching and memory switching in electroformed metal oxides的报告。

报告中，Jordi Suné教授首先简要介绍了其研究小组的成员以及各自的研究方向，简述了其在氧化物可靠性领域的一些研究结果与进展。报告主要围绕着threshold switching 与memory switching 的对比展开，以其研究小组的实验结果为例，展示了不同实验条件与不同器件结构下的数据结果，并且提出了QW模型来解释电荷的隧穿机制和电阻转变，得到了一系列的结论，最后就两种switching 方式目前仍存在的一些问题进行讨论与提问。

Jordi Suné教授1989年博士毕业于巴塞罗那自治大学物理系。2002年成为巴塞罗那自治大学电子工程系的全职教授。于1996-2002 期间为电子工程系主任，并从2011年起至今继续做电子工程系的主任。1989年秋在IMEC做过研究学者，1990年和1991在博洛尼亚大学做过访问学者。Jordi Suné教授在期刊或会议上发表过300多篇文章，其中有13篇IEDM 会议文章和一些约稿文章，并分别于2001, 2004, 2005, 2008, 2009年在IEEE-IRPS发表过5篇有关氧化物可靠性的指南性文章。这些文章总引用次数1900次以上，H-index 为23，并多次获得政府和企业的多种奖项。



附件下载:



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编: 100029

单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号, 电子邮件: [webadmin@ime.ac.cn](mailto:webadmin@ime.ac.cn)

京公网安备110402500036号